EXPOSURE DEVICE

Patent Number:

JP61196532

Publication date:

1986-08-30

Inventor(s):

TSUKAMOTO IZUMI

Applicant(s):

CANON INC

Requested Patent:

✓ JP61196532

Application Number: JP19850035267 19850226

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/30; G03F7/207

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To enable to enter all picture images to be exposed into specified focal depth by a method wherein the surface shape of wafer is preliminarily detected before exposure to autofocus comforming to the surface shape.

CONSTITUTION: A wafer chuck 7 with a wafer 6 preliminarily attracted thereto is arranged below a laser interferometer 1. The interferostripes are produced by an autofocus detecting mechanisms 3a and a laser interferometer 1 while the reference plane 33 of surface 30 is decided so that the surface 30 may enter into the specified focal depth of a projection optical system 9 in terms of the calculated results of wafer surface 30 shape by an inteferostripe processor 4 and the wafer chuck focus reference plane 31 as well as the measured results of surface shape of wafer 6. Finally the excellent resolving power of projection optical system 9 may be displayed by means of focussing the reference plane on the specified focal plane of projection optical system 9 by controlling an autofocus driving mechanism 8b conforming to the output from an autofocus driving control mechanism 5 memorizing the relation between the measured results of reference plane 31 and the reference planes 33, 31 of wafer surface 30.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 196532

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)8月30日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/207 Z-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭60-35267

20出 願 昭60(1985)2月26日

@発明者 塚本

泉 川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

の出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

60代 理 人 弁理士 伊東 辰雄 外1名

明報 🖀

1. 発明の名称

露光装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 露光に先立って被露光体の表面形状を検出する検出手段と、該被露光体を露光位置でオートフォーカスする際に上記検出手段の出力に応じてオートフォーカスの駆動を制御する制御手段とを有する露光装置。
- 2. 前記被露光体の表面形状検出を露光位置と 異なる位置で行なう特許請求の範囲第1項記載の 露光装置。
- 3. 前記制御手段が、前記検出手段の出力に基づいて被露光体基準面を算出するとともに、この被露光体基準面を結像面に合致させるべく前記オートフォーカス手段を駆動する特許請求の範囲第1または2項記載の露光装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の分野]

本発明は、露光装置、例えば半導体製造工程で

用いられる露光装置に関する。

[従来の技術]

昨今のLSI製造技術の進歩は著しく、回路パターンは高集積化のために微輔になる一方である。このため回路パターンをウエハに転写する露光装置は高解像力であるか否かが、装置の死命を左右するものとなってきた。

しかし、投影光学系を有する露光装置では、高解像力になればなるほど、焦点深度が浅くなるという問題があった。この問題に対処するため、露光装置はオートフォーカス機構を有することが必要不可欠なこととなってきた。

ところが、半導体製造工程には加熱プロセスがあり、そのためにウエハが歪んでしまい、ウエハの表面形状は凹凸になってしまう。この凹凸の表面形状を持つウエハに対しても、浅い焦点深度内にウエハ表面を位置設定できるようにオートフォーカスすることは至難の楽であった。

たとえば、従来の貧光装置では、オートフォーカスのウェハ表面検出機構は、複数個であっても

このように、オートフォーカス機構を有する露 光装置でも、高い解像力を持つ投影系の性能を生かすことが出来ないという重大な欠点を持っていた。

[発明の目的]

本発明の目的は、前述の従来例の欠点に鑑み、露光装置において、露光前に予めウェハの表面形状を検出し、この表面形状に応じてオートフォーカスを行なうという構想に基づき、露光する全面面を所望の焦点深度内に合わせることを可能にすることにある。

また、本発明は、同時に所望の焦点深度内に入

ートフォーカス駆動機構、 9は集積回路パターンをウエハ6に転写する投影光学系、10は集積回路パターンが描かれたマスク、11は集積回路パターンを焼付けるための光源を搭載した照明系、3bは投影光学系9のピント面にウエハ6を位置させるためのオートフォーカス検出機構3bの出力及びオートフォーカス駆動が機構3bの出力及びオートフォーカス駆動が機構5の出力によって駆動されるオートフォーカス駆動機構である。

第2図は、第1図のレーザ干渉計1とその関連部分の構造を示す詳細図である。ここでは、オートフォーカス検出機構3a、3bとしてエアーセンサを使用した実施例について述べる。第2図の21はオートフォーカス検出機構3aのエアーセンサのノズル先端を示す。また、22はウエハチャック1上に設けられたウエハチャックフォーカス検知面である。

第3 図は、本発明のオートフォーカス検出機構 3aとレーザ干渉計1 を使用して計測を必要とする れることが出来ない程悪い表面形状をもつウェハあるいはステップアンドリピート方式の露光装置の場合はそのステップを、露光等の作業をせずに飛び越すことにより無駄な作業を行なうことを可能とする け、スループットを向上させることを可能とすることを第2の目的とする。

[実施例の説明]

基準面の説明図であり、ウエハチャックフォーカス検知面 22に対して、ウエハチャックフォーカス 基準平面 31、エアーセンサノズル先端 21によって 計測されるウエハ表面 30の仮基準平面 32、及びレーザ干渉計1の計測結果から干渉 44 演算装置4の 演算によって求まるウエハ表面 30の基準平面 33の 1 例を図示したものである。

 直面内の傾きを調整する。

この参照平面2 とオートフォーカス検出機構3aの各々は予め表面形状が既知のものを使って、その相対位置関係を測定しておき、オートフォーカス駆動機構8aにオフセットとして入力しておく。このようにしておけば、エアーセンサの取付け誤
差等によって仮基準平面32の測定が影響されることを防ぐことが出来る。

により、投影光学系9の下にあるオートフォーカス駆動機構8bの上に設置される。投影光学系9に対するウェハ6のオートフォーカスは、オートフォーカス検出機構3bにより、ウェハチャックフォーカス基準平面31の計測結果とウェハチャックの38とウェハチャックフォーカス駆動機構8b

構5の出力に従ってオートフォーカス駆動機構8b

を制御し、投影光学系9の所定のピント面にウェーハ6の基準平面を合致させることによって行なう。

行なう。

この後、可びエアーセンサノズル先端 21よりエアーを吹き出し、ウエハチャック 7 のウエハ 6 より外側に設けられたウエハチャックフォーカス 検知面 22を計測する。この計測結果から求まるウエハチャックフォーカス 基準平面 31と前述のとおりに求められたウエハ表面 30の 仮基準平面 32との 関係がオートフォーカス駆動制御機構 5 にデータとして送られる。

また、干渉橋添算装置4 は、計測されたウエハ6 の表面形状より投影光学系9 の所望の焦点深度内にウエハ6 の表面が入るようにウエハ 表面 30の基準平面 32との関係をオートフォーカス駆動制御機構5 に出力する。オートフォーカス駆動制御機構5 は、ウエハ6 の表面の仮基準平面 32を介して 基準平面 33とウェハチャックフォーカス基準平面 31を演算し記憶する。

以上の測定及び演算が終了した後ウェハ 6 及び ウェハチャック 7 は、図示されていない駆動機構

定させる。このとき、リミット値を越えるようなウエハに対しては、露光せずにウエハ表面平面度不良としてオミットし、スループットを向上させることも可能である。なお、本実施例において、ウエハチャック7を複数個使用すればウエハ表面の計測と露光動作が平行して行なえるので従来方式と同じスループットを保つことができる。

第4図は、露光装置がステップアンドリピート式の場合の本発明の実施例であり、露光部分分のみを示している。その他の構成は、第1図と全く同じでよいため省略してある。第4図において、ウエハチャック7及びオートフォーカス駆動機構 8bは X Y ステージ 12の駆動を繰り返すことによっている。

このステップアンドリピート式の露光装置の場合は、第5回に示すように1回の露光範囲ごとにウエハ表面30の基準表面33(第5回には33a~dの4つが示してある)を干渉稿演算装置4で演算し、その各々の基準平面33とウエハチャックフォ

特開昭61-196532(4)

なお、前述の実施例では、オートフォーカス検 出機構にエアーセンサを用いているが、これは光 学的な検出手段あるいは静電容量を測定する電気 的な検出手段を用いてもよい。

[発明の効果]

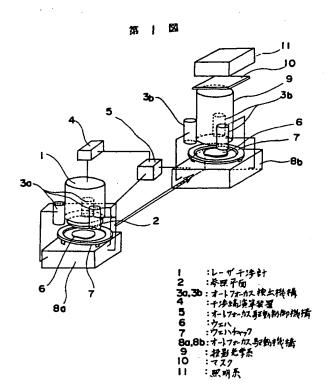
以上の如く、本発明によれば、露光装置の投影系の高い解像力を有効に生かすことができるという効果がある。また、解像不良となるウエハ表面形状を持つウエハに対しては、露光前にそのことがわかるので無駄な露光を行なわずに済ませ、ス

ループット向上を計る効果がある。

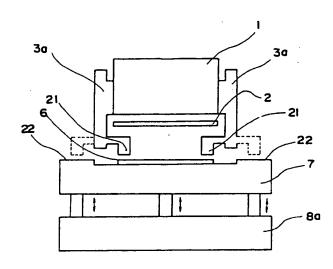
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例に係る露光装置の概略構成図、第2 図はウエハの表面形状を検出する検出機構の詳細図、第3 図は本発明で計測を必要を示した図、第4 図は本発明が適用されるステップアンドリピート式の露光装置の露光部分の概略装置の場合に計測を必要とするウエハの表面形状と基準平面の関係を示した図である。

1: レーザ干渉計、 2: レーザ干渉計1 の参照 平面、3a、3b: オートフォーカス検出機構、 4: 干渉稿演算装置、 5: オートフォーカス駆動制御機構、 6: ウェハ、 7: オートフォーカス検知面 22を持つウェハチャック、8a、8b: オートフォーカス駆動機構、33、33a ~33d : ウェハ表面基準平面。



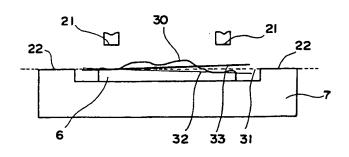
第 2 図



1:レーザ干渉計

2:参照平面 3a:1-1万-奴授出機構

6:ウェハ 7:ウェハヤック 80:オートフォールを動機構 21: エアセンナノズル党場 22: なハチャックフォー放奏準面



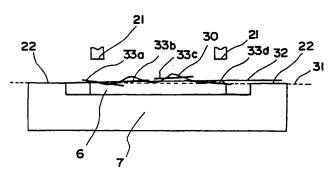
6:ウェハ 7:ウェハナマック 21:エア・センタ バル上球内 22:ウェハチャックフォーカス 検や面 30:ウェハ表面 31:ウェハナマックフォーカス基準平面 32:ウェハ表面仮基準平面 33:ウェハ表面を基準平面

3ь 3ь 6 8p .12

オートフォーカス検出機構 ウェハ ウェハチャック オートフォー加原動機構 投影系 X Y ステージ 3ь 6 7 8ь

9

第 5 🛚



6:ウェハ 7:ウェハナャック 21:エアセンサ バル先端 22:ウェハチャックオーカス検知面 30:ウェハ表面 31:ウェハチャックフォーか基準平面 32:ウェハ表面仮基準平面 330,b,c,d:

·2.1.表面基準平面